

Q. Metrology, Inspection, and Yield Enhancement 분과

Room A

창의관 (106)

일 시 : 2월 17일(금) 13:40-15:10

세션명 : [FA3-Q] Q II

좌 장 : 유형원(하이닉스반도체), 김호섭(선문대학교)

FA3-Q-1 13:40-14:10 **[Invited]**High Speed Full Wafer Monitoring of Surface, Edge and Bonding Interface for 3D-stacking

저자: Pierre-Yves Guittet, Lars Markwort, Greg Savage, and Christoph Kappel
소속: Nanometrics GmbH

FA3-Q-2 14:10-14:25 탐침현미경-전자현미경 결합과 반도체 기술

저자: 박병천¹, 이주엽², 송운¹, 김달현¹, 홍재완²
소속: ¹한국표준과학연구원, ²㈜나노포커스

FA3-Q-3 14:25-14:40 FE-(S)TEM을 이용한 GaN계 LED의 미세구조 분석

저자: 양준모¹, 박중식^{1,3}, 박경진¹, 박윤창¹, 유정호¹, 정철성¹, 이상걸², 신기삼³
소속: ¹나노종합팹센터, ²한국기초과학지원연구원, ³창원대학교 나노신소재공학과

FA3-Q-4 14:40-14:55 Strategy of Yield Ramp-up using Test Vehicle and the Simulation of Yield Prediction

저자: Jun-Woo Lee, Hyo-Jin Kim, Kyoung-mi Park, Seung-Woo Do, Jong-Hyun Lee, and Nae-In Lee
소속: Technology Development-1 / TD, System LSI Division, Samsung Electronics Co., Ltd.